

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【公表番号】特表2010-532585(P2010-532585A)

【公表日】平成22年10月7日(2010.10.7)

【年通号数】公開・登録公報2010-040

【出願番号】特願2010-515106(P2010-515106)

【国際特許分類】

H 01 L 21/322 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/322 J

【手続補正書】

【提出日】平成23年4月8日(2011.4.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0032】

### III. エピタキシャル層

再び図1を参照すると、エピタキシャル層11は、本技術分野で一般的に知られている手法によって、アニールされたシリコンウェーハの表面に堆積あるいは成長される。シリコンウェーハの表面には転位ループがないのが好ましい。ある実施態様では、エピタキシャル層の平均厚さは少なくとも約 $5\text{ }\mu\text{m}$ である。ある実施態様では、注入基板をアニールして転位ループを生み出した後に、エピタキシャル層11を成長させる。別の実施態様では、注入基板をアニールして転位ループを生み出すとともに、エピタキシャル層11を成長させる。さらに別の実施態様では、エピタキシャル層を成長させる前あるいは成長させた後に、注入ウェーハを部分的にアニールして転位ループを生み出す。したがって、有利には、アニーリング工程およびエピタキシャル成長工程は同じ装置中で行なわれるだろう。